

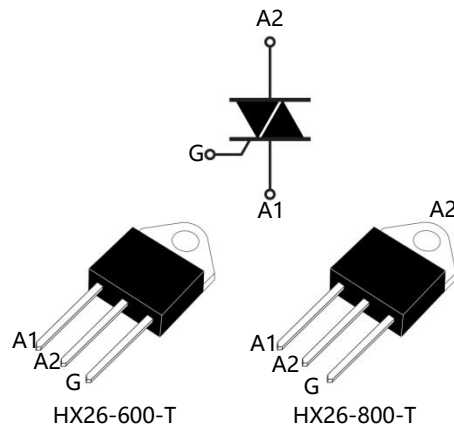
HX26-600-T/HX26-800-T 双向可控硅

特征

NPNPN 五层结构的硅双向器件，采用单面挖槽工艺和台面玻璃钝工艺，配备背面多层金属电极。这款器件具备出色的阻断电压和温度稳定性，可靠性高。

应用

- 吸尘器、电动工具等马达调速控制器开关电源
- 固态继电器、加热控制器（调温）
- 其他相控电路



极限参数

符号	参数名称	数值	单位
IT(RMS)	通态方均根电流	HX26-600-T Tc=80°C	26 A
		HX26-800-T Tc=90°C	
ITSM	通态浪涌电流	F=50HZ t=20ms	260 A
I2t	I2t 的极限值	tp= 10ms	340 A ² S
di/dt	通态电流临界上升率	Tj=125°C	50 A/us
VDRM/VRRM	断态重复峰值电压/反向重复峰值电压	Tj=25°C	800/1000 V
IGM	门极峰值电流	tp=20us Tj=125°C	4 A
PG(AV)	门极平均耗散功率	Tj=125°C	1 W
Tstg	储存温度		-40to+150 °C
Tj	有效结温		-40to+125 °C

静态参数

符号	名称和测试条件	数值	单位
V _{TM}	通态峰值电压 ITM= 52A Tj=25°C	MAX	1.50 V
V _{T0}	门槛电压 Tj=125°C	MAX	0.85 V
R _d	斜率电阻 Tj=125°C	MAX	9.2 mΩ
I _{DRM}	断态峰值电流 Tj=25°C	MAX	10 uA
I _{RRM}	反向峰值电流 Tj=125°C		2 mA
R _{th(j-c)}	结壳热阻	HX26-600-T	0.9 °C/W
		HX26-800-T	0.6 °C/W

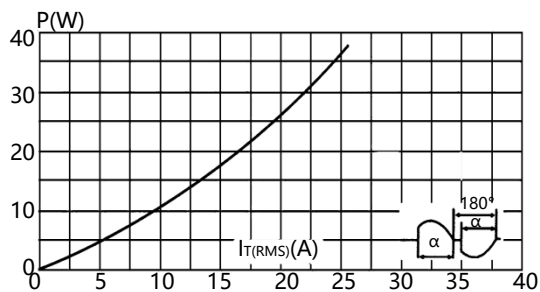
电特性 (三象限)

符号	名称和测试条件	象限		数值	单位
IGT	触发电流 VD= 12V RL= 100Ω	I	MAX	≤50	mA
VGT	触发电压	II	MAX	1.5	V
VGD	不触发电压 Tj=125°C	III	MIN	0.2	V
IH	维持电流 IT=0.5A		MAX	60	mA
IL	擎住电流 IG= 1.2IGT		MAX	60 100	mA
dv/dt	断态电压临界上升率 VD=2/3VDRM Tj=125°C		MIN	500	V/us
(dv/dt)c	换向电压临界上升率 Tj=125°C		MIN	10	V/us

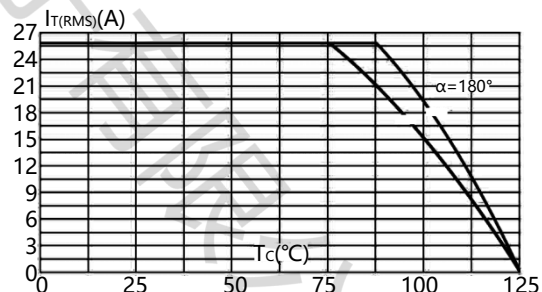
电特性 (四象限)

符号	名称和测试条件	象限		I II III IV		单位
				I II III	IV	
IGT	触发电流 VD= 12V RL= 100Ω	I II	MAX	≤50	≤120	mA
VGT	触发电压	III	MAX	1.5		V
VGD	不触发电压 Tj=125°C	IV	MIN	0.2		V
IH	维持电流 IT=0.5A		MAX	60		mA
IL	擎住电流 IG= 1.2IGT		MAX	60 100		mA
dv/dt	断态电压临界上升率 VD=2/3VDRM Tj=125°C		MIN	500		V/us
(dv/dt)c	换向电压临界上升率 Tj=125°C		MIN	10		V/us

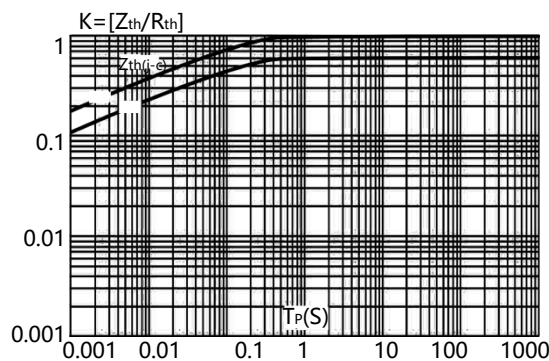
特性曲线



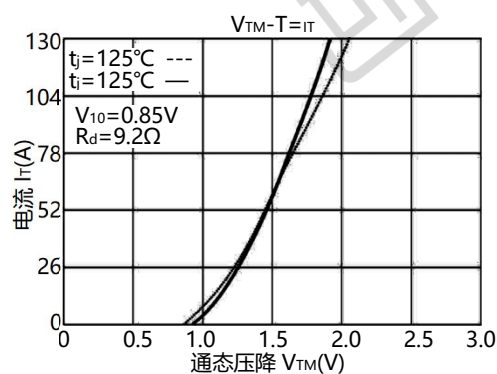
功耗与电流曲线 (180°C)



壳温与通态方均根电流曲线



瞬态热阻曲线



通态伏安特性曲线

